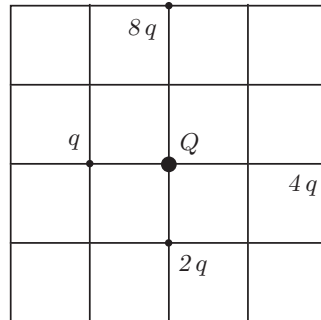


Lösningar tentamen i Elektromagnetisk fältteori för F och Pi, 19 augusti 2015

1



a) Det finns flera möjliga placeringar av laddningarna. En av dessa visas i figuren. Krafterna från de fyra laddningarna ges av Coulombs lag:

Svar:

$$\mathbf{F} = Q \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2} - \frac{4q}{4\pi\epsilon_0 (2a)^2} \right) \hat{\mathbf{x}} + Q \left(\frac{2q}{4\pi\epsilon_0 a^2} - \frac{8q}{4\pi\epsilon_0 (2a)^2} \right) \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{0}$$

b) Potentialen är en summa av de fyra laddningarnas potentialer. **Svar:**

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} + \frac{2}{a} + \frac{4}{2a} + \frac{8}{2a} \right) = \frac{9q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

2

Enklast är att se den vänstra kondensatorn som två parallellkopplade kondensatorer och den högra som två seriekopplade. Formeln för en plattkondensator ger

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{2d} (1 + \epsilon_r)$$

$$C_2^{-1} = \frac{d}{2\epsilon_0 \epsilon_r S} (1 + \epsilon_r)$$

Det ger

Svar:

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{(1 + \epsilon_r)^2}{4\epsilon_r}$$

3

a) Det är bara den mittersta slingan som ger bidrag, av symmetriskäl. Vi använder att \mathbf{B} i centrum av en cirkulär slinga ges av $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2a} \hat{\mathbf{n}}$, där i vårt fall $\hat{\mathbf{n}} = -\hat{\mathbf{z}}$. Flödestätheten är därmed:

Svar:

$$\mathbf{B} = -\frac{\mu_0 I}{2a} \hat{\mathbf{z}}$$

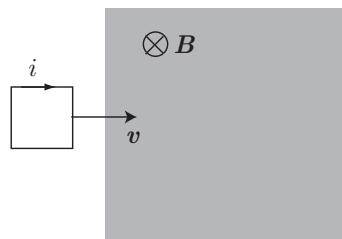
b) Av symmetriskäl ger endast den högra slingan bidrag till flödestätheten. Dess centrum ligger på avståndet $d = \sqrt{(100a)^2 + (3a)^2} \approx 100a$ från fältpunkten $(0, 100a, 0)$. Vi kan anse att $100a \gg a$ och använda dipolapproximationen för att bestämma flödestätheten. Vi kan dessutom placera denna dipol med centrum i origo eftersom avståndet till fältpunkten är stor. Dipolapproximationen ger att en dipol med magnetiska momentet $\mathbf{m} = m\hat{\mathbf{z}}$ har magnetiska flödestätheten

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2 \cos \theta \hat{\mathbf{r}} + \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}})$$

då dipolen ligger i origo. För den högra slingan gäller i punkten $(0, 100a, 0)$ att $r = 100a$, $\theta = \pi/2$ och $\hat{\boldsymbol{\theta}} = -\hat{\mathbf{z}}$. Dessutom är $m = -I\pi a^2$. Det ger

$$\mathbf{B}(0, 20a, 0) = \frac{\mu_0 I a^2}{4(100a)^3} \hat{\mathbf{z}}$$

4



a) Den inducerade emk:n är $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi(t)}{dt}$. Flödet genom slingan är

$$\Phi(t) = \begin{cases} B_0 a v_0 t, & \text{för } 0 < t < a/v_0 \\ B_0 a^2, & \text{för } a/v_0 < t < 2a/v_0 \end{cases}$$

Strömmen genom slingan är $i(t) = \mathcal{E}/R$. Detta ger

Svar:

$$i(t) = \begin{cases} -\frac{B_0 a v_0}{R}, & \text{för } 0 < t < a/v_0 \\ 0, & \text{för } a/v_0 < t < 2a/v_0 \end{cases}$$

Strömmens referensriktning ges av figuren.

b) Energin som utvecklas i slingan är

Svar:

$$W = \int_0^{a/v_0} R(i(t))^2 dt = R \left(\frac{B_0 a v_0}{R} \right)^2 \frac{a}{v_0} = \frac{B_0^2 a^3 v_0}{R}$$

5

a) För plana vågor är kvoten mellan amplituderna av de elektriska och magnetiska fälten lika med vågimpedansen, $\frac{|\mathbf{E}(\mathbf{0}, t)|}{|\mathbf{H}(\mathbf{0}, t)|} = \eta_0$. I vårt fall gäller $\frac{|\mathbf{E}(\mathbf{0}, t)|}{|\mathbf{H}(\mathbf{0}, t)|} = \alpha^{-1}$

vilket ger

Svar: $\alpha = \eta_0^{-1} = (120\pi)^{-1} \Omega^{-1}$.

b) Vågen är en cirkulärpolariserad planvåg.

c) Vågens utbredningsriktning ges av $\hat{\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{E}(\mathbf{0}, t) \times \mathbf{H}(\mathbf{0}, t)}{|\mathbf{E}(\mathbf{0}, t) \times \mathbf{H}(\mathbf{0}, t)|} = \hat{\mathbf{z}}$. Det ger

Svar: $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \hat{\mathbf{x}}E_0 \sin(\omega t - kz) + \hat{\mathbf{y}}E_0 \cos(\omega t - kz)$

6

Strömmen fördelas jämnt över det ledande skiktet. Det ger strömtätheten $\mathbf{J} = \frac{I}{\pi a^2} \hat{\mathbf{x}}$. I det ledande skiktet är, enligt Ohms lag, $\mathbf{E}(x) = \sigma(x)^{-1} \mathbf{J}$, och den elektriska flödestätheten

$$\mathbf{D}(x) = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}(x) = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r I}{\sigma(x) \pi a^2} \hat{\mathbf{x}}$$

a) Fria volym-laddningsfördelningen i det ledande skiktet ges av Gauss lag

$\rho(x) = \nabla \cdot \mathbf{D}(x) = \frac{dD(x)}{dx}$. Det ger

Svar $\rho(x) = -\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r I d}{\pi a^2 \sigma_0 (d+x)^2}$

b) Konduktiviteten i metallplattan kan antas vara oändlig och därmed är den elektriska flödestätheten i metallskivorna noll. Det ger ytladdningstätheten på den undre plattan $\rho_{S, \text{undre}} = \hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{D}(0)$ och ytladdningstätheten på den övre $\rho_{S, \text{övre}} = -\hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{D}(d)$.

Svar Laddningen på den undre respektive övre plattan är då

$$q_{\text{undre}} = \pi a^2 \hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{D}(0) = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r I}{\sigma_0}$$

$$q_{\text{övre}} = -\pi a^2 \hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{D}(d) = -\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r I}{2\sigma_0}$$

c) Totala laddningen i det ledande skiktet ges av $q_{\text{led}} = \pi a^2 \int_0^d \rho(x) dx = \pi a^2 \int_0^d \frac{dD(x)}{dx} dx = \pi a^2 (D(d) - D(0))$.

Svar: $q_{\text{led}} = -\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r I}{2\sigma_0}$